

次世代トランジスタに向けた 新規な機能性酸化物半導体チャネル材料 ・デバイス・作製技術の新展開

日時：3月16日（日）13:30～17:40

会場：ハイブリッド開催（東京理科大野田キャンパス+オンライン）

FET 100周年を記念し、次世代機能を実現する新規な半導体チャネルとしての酸化物材料に着目し、ナノ構造半導体、透明伝導体、強磁性体、パワー半導体、酸化グラフェンなどの機能物性とALDなどの作製手法、開発現場、異分野融合に関して最先端のご研究を紹介していただき、今後を展望いたします。

【招待講演者】

- 酸化物半導体トランジスタの微細化に関する研究
小林 正治（東大生研）
- ALDによる高誘電酸化物薄膜作製への化学的アプローチ
松尾 保孝（北大電子研）
- 量産可能な二次元ナノカーボンの製造法の確立と機能開拓
仁科 勇太（岡山大基礎研）
- 高速大容量メモリ実現に向けた酸化物半導体トランジスタへの期待と課題
株柳 翔一（キオクシア株式会社）
- 受動素子として優れた酸化物パワーデバイスが能動素子として世に出るためのアプローチ
金子 健太郎（立命館大学半導体応用研究センター）
- 強相関酸化物を用いたスピントランジスタ
大矢 忍（東大院工）
- 次世代FPDの要求を満たす高移動度を示す安定な酸化物薄膜トランジスタ
曲 勇作（北大電子研）

主催 応用物理学会機能性酸化物研究会

世話人：田中秀和（阪大産研）、秋永広幸（産総研） 組頭広志（東北大多元研）
松野丈夫（阪大理） 上野和紀（東大総合）、中川原修（I-PEX Piezo Solutions(株)）